(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-279323

(43)公開日 平成6年(1994)10月4日

(51) Int.Cl. ^c C 0 7 C		識別記号	庁内整理番号 9280-4H	FI					技術表示箇所
	1/32 15/52 15/56 17/26		9280-4H 9280-4H 審査請求						
				未請求 請求	請求項	項の数4 〇	OL	L (全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平5-68322		(71)	出願人	原人 000183646 出光興産株式会社			
(22)出顧日		平成5年(1993)3	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 (72)発明者 東 久洋						
					千葉県 式会社		市上泉1280番	地 出光興産株	
				(72)	発明者	東海林	弘		
						千葉県 式会社		市上泉1280番	地 出光興産株
				(72)	発明者	110-1			late and the same safe late.
						干菜県 式会社		巾上泉1280番	地 出光興産株
				(74)	代理人		 : 大谷	保	

(54) 【発明の名称】 新規スチリル化合物、その製造法およびそれからなる有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【目的】 藤膜性に優れ、高輝度発光を可能とする新規 スチリル化合物, その製造法およびそれからなる有機E* * L素子の開発。

【構成】 一般式(1) (化1)

(式中の記号、明細書に記載の通りである。) で表され

る新規スチリル化合物。

* (化1)

[4:21

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式(1)

CH -CH

1

(式中、Arは炭素数6~20の置換あるいは無置換の アリール基を示し、R', R² はそれぞれ水素原子、図 換あるいは無償機の炭素数6~20のアリール基。また は炭素数1~6のアルキル基を示す。R3 は置換あるい は無置換の炭素数6~20のアリール基、または炭素数 4~18の複素理基を示す。ここで、R1~R3 は同一 でも、互いに異なっていてもよい。さらに、R°とR° はそれぞれ仮換している基と結合して置換あるいは無償 様の飽和五日理または間様あるいは無間様の飽和六日理 を形成してもよい。ここで、置換基としては炭素数1~ 6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数 6~18のアリールオキシ基、フェニル基、アミノ基、※ ※シアノ基、ニトロ基、水酸基あるいはハロゲンを示す。 これらの置換基は単一でも複数置換されていてもよい。 また、Xは水素あるいは

$$\frac{R_3}{R_3} > C = \frac{C}{R_1}$$

(式中、R! ~R* は前記と同じである。)) で表され る新規スチリル化合物。

(式中、Rは炭素数1~4のアルキル基あるいはフェニ ル基を示し、R1 ~R3およびArは前記と同じであ る。) で表されるホスホン酸エステルを塩基の存在下で カップリングさせることを特徴とする請求項1配載の新 規スチリル化合物の製造法。

【餅求項3】 有機エレクトロルミネッセンス素子にお 合物を挟持してなる有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【簡求項4】 有機エレクトロルミネッセンス素子にお いて、発光層の発光材料が請求項1記載の新規スチリル 化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子。

[発明の詳細な説明]

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、新規スチリル化合物, その製造法およびそれからなる有機エレクトロルミネッ に優れ、高輝度発光を可能とする新規スチリル化合物。 その製造法およびそれからなる有機EL素子に関する。

[0002] 【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】電界発 光を利用したEL表子は、自己発光のため視認性が高 く、また完全固体素子であるため耐衝撃性に優れるとい いて、陽板と除板の間に請求項1記載の新規スチリル化 40 う特徴を有しており、薄型ディスプレイ案子、液晶ディ スプレイのパックライト、平面光源などに用いられてい る。現在実用化されているEL素子は、分散型EL素子 である。この分散型EI.妻子は、数10V. 10kHz 以上の交流電圧を必要とするため駆動回路が複雑になっ ている。一方、有機薄膜EL素子は駆動電圧を10V程 度まで低下させることが出来、高輝度に発光するため近 年盛んに研究が行われ、多くの有機薄膜EL素子が開発 されている (C. W. Tang and S. A. VAN Slyke, Appl. Phys. L ett., vol. 51, pp. 913~915(1987) ; 特開平63-264 センス素子(有機EL素子)に関し、詳しくは、蒜酸性 50 629号公報)。これらの有機薄膜EL素子は、透明電 極/正孔注入層/発光層/背面電極の積層型であり、正 引注入層により効率よく正孔を発光層内へ注入すること ができる。上記有機薄膜EL素子の構成において、発光 層にテトラフェニルプタジエン化合物誘導体を用いた有 機EL菰贈素子(特開図59-194393号公報、特 関平4-96990号公報) やスチリル化合物 (欧州特 許公開第0388768号公報,特開平4-18489 2号公報, 特別平3-205478号公報) を用いたも のがある。また、近年上記スチリル化合物より派生した 3 官能化合物を発光材料として含有する有機EL業子が 10 【0005】 関示されているが、輝度および発光効率が低いという問 題がある。この問題は、発光材料が結晶化することが原*

3

*因である。

[0 0 0 3]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 上記問題点を解決すべく鋭意検討した結果、スチリル化 合物のオレフィン部位が多数存在することにより多種多 様の構造が可能となり、それにより分子の再配列(結晶 化)を防ぐことを見出した。

【0004】本発明はかかる知見に基づいて完成したも のである。すなわち本発明は、一般式 (!)

[化4]

$$R^{\frac{1}{2}} > C = C$$

【0006】(式中、Arは炭素数6~20の置換ある いは無置換のアリール基を示し、R1、R2 はそれぞれ 水素原子、優換あるいは無管機の炭素数6~20のアリ ール基。または炭素数1~6のアルキル基を示す。R3 は置換あるいは無置換の炭素数6~20のアリール基。 または炭素数4~18の複楽環基を示す。ここで、R1 ~R3 は同一でも、互いに異なっていてもよい。さら に、R² とR³ はそれぞれ登場している基と結合して置 換あるいは無置換の飽和五員環または置換あるいは無置 換の飽和六員環を形成してもよい。ここで、置換基とし ては炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコ キシ基、炭素数6~18のアリールオキシ基、フェニル 其、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基あるいはハ※ ※ロゲンを示す。これらの置換基は単一でも複数置換され ていてもよい。また、Xは水素あるいは

[0007] KK.51

$$\frac{R^2}{R^2}$$
 $> c = \frac{R^1}{C}$

[0008] (式中、R! ~R3 は前紀と同じであ る。)) で表される新規スチリル化合物を提供し、一般 式 (II)

[0009]

[化6]

[0010] (式中、Rは炭素数1~4のアルキル基あ るいはフェニル基を示し、R! ~R3、XおよびArは 前配と同じである。) で歩されるホスホン酸エステルを 塩基の存在下でカップリングさせてなる上配新規スチリ ル化合物の製造法および上記新規スチリル化合物を挟持 してなる有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する 50 【化7】

ものである。

[0011] 本発明は、一般式(I) で表される4官能 スチリル化合物を提供する。ここで、一般式 (1) にお いてArは、i) Xが水素の場合 [0012]

101 · 300-00 · 00-00(· 1000 · 400 · Q-Q-Q · XX-Q-Q 0-12-0 · 12-0-0 · 12-0-0

[0013]

000 · 1000 · 000 ·

[0014] フェナントレン: ペリレン: 1. 2-ペン ゾアントラセン:ナフタセン:クリセン:クオーターフ [0015] ェニレンなどの任意の結合位置を有する3価の芳香族炭 20 【化9】 化水素であり、単一個換でも複数個換されていてもよ※

【0016】 フェナントレン: ペリレン: 1. 2-ペン ェニレンなどの任意の結合位置を有する4価の芳香族炭 化水素であり、単一置換でも複数置換されていてもよ い。R1 、R2 は、例えばフェニル基、ナフチル基、ビ フェニル基、ターフェニル基、アントラリル基、フェナ ントリル基、ピレニル基、ベリレニル基などで表される 炭素数6~20のアリール基またはメチル基。エチル 基、nープロビル基、iープロビル基、nープチル基。 i-プチル基、scc-プチル基、t-プチル基、i-ベンチル基、 t-ペンチル基、ネオペンチル基、n-ヘ

のアルキル基であり、同一でも異なってもよい。これら ゾアントラセン; ナフタセン; クリセン; クオーターフ 40 アリール基またはアルキル基は、置換または無置換でも よく、単一置換でも複数置換されていてもよい。R * は、例えばそれぞれフェニル甚, ナフチル基, ピフェ ニル基、ターフェニル基、アントラリル基、フェナント リル基、ピレニル基、ペリレニル基などで表される炭素 数6~20のアリール基またはピラジル基、ピリジル 基、キノリル基、カルパゾリル基、キノキサリル基など で表される炭素数4~18の複素環基である。これらア リール基または複素環基は、置換または無置換でもよ く、単一個換でも複数置換されていてもよい。さらに、 キシル基、1-ヘキシル基などで表される炭素数1~6 50 R°とR°はそれぞれ質換している基と結合して質換あ

るいは無置換の飽和五員環または置換あるいは無置換の 飽和六員環を形成してもよい。ここで、置換基としては 例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロ ピル基、n-プチル基、i-プチル基、sec-プチル 基、t-プチル基、i-ペンチル基、t-ペンチル基、 ネオペンチル基、n-ヘキシル基、i-ヘキシル基など の炭素数1~6のアルキル基、メトキシ基、エトキシ 基、プロポキシ基、1-プロポキシ基、プチルオキシ 基、i-プチルオキシ基、sec-プチルオキシ基、i -ペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ基、n-ヘキ シルオキシ基などの炭素数1~6のアルコキシ基、フェ ノキシ基、ナフチルオキシ基など炭素数6~18のアリ ールオキシ基、フェニル基、アミノ基、シアノ基、ニト 口基、水酸基あるいはハロゲンが挙げられる。具体的 に、アミノ基としては

[0017]

[(E10]



[0018] (式中、R⁴ , R⁵ は炭素数1~6のアル* *キル基または置換あるいは無置換の炭数6~20のアリ ール基を示す。R4 , R6 は同じでも異なっていてもよ い。) で表される化合物が挙げられる。

【0019】上記一般式 (I) で表される新規スチリル 化合物は、上記一般式 (II) で表されるホスホン酸エス テルをカップリング反応させることにより合成すること ができる。この反応は、塩基存在下、極性溶媒中で、窒 温から用いる溶媒の沸点までの温度範囲で通常行われ る。具体的には、一般式 (II) のホスホン酸エステル、 10 等当量以上の塩基および極性溶媒を同時に混合し、所定 の温度で反応させる。また、ホスホン酸エステルを極性 溶媒に溶解した後、塩基を添加し所定の温度で反応させ る。反応終了後、大量の水中もしくは塩を溶解した飽和 水溶液に注ぎ込み、得られる固体を収集するか、得られ た固体を任意の有機溶媒に溶解させ分取し、有機溶媒を 除去することにより、目的の新規スチリル化合物を得る ことができる。 ここで、一般式 (II) のRは低級アル キル基として炭素数1~4のアルキル基およびフェニル 其を示し、メチル基、エチル基であることが好ましい。 20 一般式 (II) で表されるホスホン酸エステルは、一般式

(III) または (IV) [0020]

(化11)

【0021】 (式中、R1 およびArは前記と同じであ 30%とができる。値に、一般式 (II) で奏されるホスホン酸 る。またYはそれぞれハロゲンを示し、互いに同じでも 異なってもよい。) で表される化合物と P (OR) :

(式中、Rは前記と同じである。) とを反応して得るこ※

エステルは、一般式 (V) または (VI) [0022]

【化12】

【0023】 (式中、R. R) およびArは前記と同じ [0024] である。) で表されるホスホン酸エステルと一般式 (VI (化13]



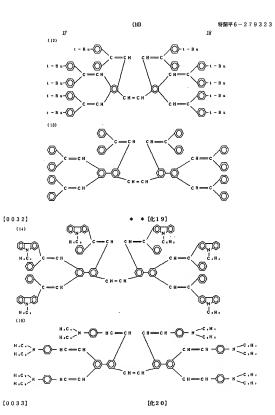
【0025】 (式中、R²、R³ は前配と同じであ る。) で表されるカルポニル化合物のモル比を制御して 反応させることにより得ることができる。具体的には、 一般式(V)のホスホン酸エステルに対しては2倍モル ホン酸エステルに対しては3倍モルの一般式 (VII)カル ポニル化合物を反応させることにより一般式 (II) のホ スホン酸エステルを得ることができる。但し、反応温度 によては、この反応により、一般式 (II) のホスホン酸 エステルを経由せずに直接一般式 (1) の新規スチリル 化合物を得ることも可能である。新規スチリル化合物の 合成で用いる塩基としては、種々挙げられるが水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、ナトリウムメチラート、ナ トリウムエチラート、カリウムー t - プトキサイド、ナ トリウムアミド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、 20 【化14】

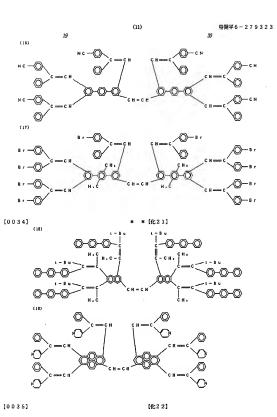
リチウムジイソプロピルアミドなどが挙げられる。ま た、反応溶媒としては、炭化水素、アルコール類、エー テル報などの極性姿態が好ましい。具体的には、メタノ ール: エタノール: イソプロパノール: ブタノール: 2 -メトキシエタノール:1,2-ジメトキシエタノール などのアルコール系溶媒、ジエチルエーテル、エチレン グリコール, ジメチルエーテル, ジエチレングリコール ジメチルエーテル、ピス (2-メトキシエチル) エーテ ル. ジオキサン. テトラヒドロフランなどのエーテル系 の一般式 (VII)カルポニル化合物、一般式 (VI) のホス 10 溶媒、ペンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶 媒、:ジメチルスルホキシド:N. N-ジメチルホルム アミド: N-メチルピロリドン: 1, 3-ジメチル-2 ーイミダゾリジノンなどが挙げられる。特に、テトラヒ ドロフラン、ジメチルスルホキシドが好適である。 【0026】以下に、本発明で用いられる新規スチリル 化合物の具体例(1)~(20)(以下、化合物(1) ~ (20) と略称する場合がある。) を挙げるが、本発 明はそれらに限定されるものではない。 [0027]

-192-

(化16)

[0029]





【0036】このようにして得られた本発明の前記一般 式(1)で表される新規スチリル化合物は、有機EL素 子における発光材料または正孔注入輸送材料として有効 である。この新規スチリル化合物を発光層とする場合 は、例えば蒸着法、スピンコート法、キャスト法などの 公知の方法によって、一般式 (I) の新規スチリル化合 物を疎聴化してことにより形成することができるが、特 に分子堆積膜とすることが好ましい。ここで分子堆積膜 とは、核化合物の気相状能から沈着され形成された膵臓 20 層/陰極。(3) 陽極/正孔往入輸送層/発光層/電子 や、該化合物の溶液状態又は液相状態から固体化され形 成された膜のことであり、例えば蒸着膜などを示すが、 通常この分子堆積際はLB法により形成された薄膜(分 子累積膜) とは区別することができる。また、該発光層 は、特開昭59-194393号公報などに開示されて いるように、樹脂などの結婚剤と核化合物とを、溶剤に 溶かして溶液としたのち、これをスピンコート法などに より蒋瞨化し、形成することができる。このようにして 形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、適 官状況に応じて選ぶことができるが、通常5nmないし 30 5 umの範囲で選定される。

【0037】この有機EL素子における発光層は、 (1) 億界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層により正 孔を注入することができ、かつ陰極又は電子往入層より 電子を注入することができる注入機能。(2)注入した 賃荷(賃子と正孔)を質界の力で移動させる輸送機能、 (3) 電子と正孔の再結合の場を発光層内部に提供し、 これを発光につなげる発光機能などを有している。な お、正孔の作入されやすさと、電子の往入されやすさに 違いがあってもよいし、正孔と電子の移動度で表される 輸送能に大小があってもよいが、どちらか一方の電荷を 移動することが好ましい。この発光層に用いる前記一般 式(1)で表される化合物は、一般にイオン化エネルギ 一が6.0eV程度より小さいので、適当な緊痛金属又は 陽極化合物を選べば、比較的正孔を注入しやすい。また 低子銀和力は2.8 e V程度より大きいので、適当な降極 金属又は陰極化合物を選べば、比較的電子を注入しやす い上、電子、正孔の輸送能力も優れている。さらに固体 状態の蛍光性が強いため、該化合物やその会合体又は結

光に変換する能力が大きい。

【0038】本発明の新規スチリル化合物を用いた有機 EL素子の構成は、各種の態様があるが、基本的には、 一対の領極 (陽極と験極) 間に、前記発光層を挟持した 構成とし、これに必要に応じて、正孔注入輸送層や電子 注入層を介在させればよい。介在方法としては、ポリマ 一への混ぜ込みや同時吸着がある。具体的には(1)場 極/発光層/除極。(2)陽極/正孔注入輸送層/発光 注入層/陰極。(4)陽極/発光層/電子注入層/陰極 などの構成を挙げることができる。該正孔注入輸送層や **催子注入層は、必ずしも必要ではないが、これらの層が** あると発光性能が一段と向上する。また、前配構成の索 子においては、いずれも其板に支持されていることが好 ましく、該基板については特に制限はなく、従来EL素 子に慣用されているもの、例えばガラス、透明プラスチ ック、石英などから成るものを用いることができる。

【0039】この有機EL素子における陽極としては、 仕事関数の大きい (4 e V以上) 金属、合金、低気伝導 性化合物及びこれらの混合物を低極物質とするものが好 ましく用いられる。このような電極物質の具体例として はAuなどの金属、Cul. iTO、SnOz、ZnO などの懸気性透明材料が挙げられる。鞍陽板は、これら の電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、 **瀬悶を形成させることにより作製することができる。こ** の電極より発光を取り出す場合には、透過率を10%よ り大きくすることが望ましく、また、電極としてのシー ト抵抗は数百Q/□以下が好ましい。さらにこの際原は 40 材料にもよるが、通常10nmないし1μm, 好ましく は10~200nmの範囲で選ばれる。

【0040】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下) 金属、合金、電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウ ムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシ ウム/銅混合物、AI/AIO2、インジウムなどが挙 げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッ タリングなどの方法により、薄膜を形成させることによ 品などの電子と正孔の再結晶時に形成された励起状態を 50 り、作製することができる。また、電極としてのシート 抵抗は数百Ω/□以下が好ましく、膜厚は通常10nm ないし.1 mm、好主しくは50~200nmの範囲で認 ばれる。なお、このEL素子においては、核脳極叉は除 極のいずれか一方が透明又は半透明であることが、発光 を誘過するため、発光の取出し効率がよく好耦合であ

【0041】本発明の有機EL素子の構成は、前記した ように、各種の態様があり、前配 (2) 又は (3) の構 成のEL妻子における正孔注入輸送層は、正孔伝達化合 層に伝達する機能を有し、この正孔注入輸送層を陽極と 発光層との間に介在させることにより、より低い電界で 多くの正孔が発光層に注入される。その上、発光層に陰 極又は電子往入層より往入された電子は、発光層と正孔 注入輸送層の界面に存在する電子の障壁により、この発 光層内の界面付近に蓄積されEL素子の発光効率を向上 させ、発光性能の優れたEL素子とする。

【0042】前記正孔注入輸送層に用いられる正孔伝達 化合物は、電界を与えられた2個の電極間に配置されて へ伝達しうる化合物であって、例えば10°~10°V / cmの世界印加時に、少なくとも10⁻⁶ cm² / (V ・秒) の正孔移動度をもつものが好適である。このよう な正孔伝達化合物については、前記の好ましい性質を有 するものであれば特に制限はなく、従来、光導電材料に おいて、正孔の電荷輸送材として慣用されているものや 有機EL索子の正孔注入輸送層に使用される公知のもの の中から任意のものを選択して用いることができる。

【0043】核電荷輸送材としては、例えばトリアゾー ル脎業体(米国特許第3.112.197号明細典などに記 30 げることができる。 載のもの)、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3.1 89,447号明細書などに記載のもの)、イミダゾール 誘導体(特公昭37-16096号公報などに記載のも の)、ポリアリールアルカン誘導体(米国特許第3.61 5,402 号明細書, 同3,820,989 号明細書, 同3,5 42.544 号明細書, 特公昭45-555号公報, 同5 1-10983号公報, 特開昭51-93224号公 報,同55-17105号公報,同56-4148号公 報、同55-108667号公報、同55-15695 3号公朝、同56-36656号公朝などに記載のも の)、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体(米国特 許第3,180,729 号明細書, 同4,278,746 号明細 赛. 終開取55-88064号公朝. 同55-8806 5号公報、同49-105537号公報、同55-51 086号公報。同56-80051号公報。同56-8 8141号公報, 同57-45545号公報, 同54-112637号公報。同55-74546号公報などに 記載のもの)、フェニレンジアミン誘導体 (米国特許第 3.615.404 号明細書, 特公昭51-10105号公

報, 特開昭54-53435号公報, 同54-1105 36号公報、同54-119925号公報などに記載の もの)、アリールアミン誘導体(米国特許第3.567.4 50 号明細書、同3.180.703 号明細書、同3.24 0.597 号明細書。同3.658.520 号明細書。同4.2 32.103 号明細書。同4.175.961 号明細書。同 4,012,376号明細書,特公昭49-35702号公 報, 同39-27577号公報, 特開昭55-1442 50号公朝, 同56-119132号公朝, 同56-2 物からなる層であって、陽極より注入された正孔を発光 10 2437号公報。西独特許第1,110,518号明細書な どに記載のもの)、アミノ慴換カルコン誘導体(米国特 許第3,526,501 号明細書などに記載のもの)、オキ サゾール誘導体 (米国特許第3.257.203 号明細書な どに記載のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特別 昭56-46234号公報などに記載のもの)、フルオ レノン誘導体(特開昭54-110837号公報などに 記載のもの)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,71 7.462 号明细告, 特開昭54-59143号公報, 同 55-52063号公報,同55-52064号公報。 陽極から正孔が注入された場合、該正孔を適切に発光層 20 同55-46760号公報。同55-85495号公 報,同57-11350号公報,同57-148749 号公報などに記載されているもの)、スチルベル誘導体 (特開昭61-210363号公朝, 同61-2284 51号公報, 同61-14642号公報, 同61-72 255号公報, 同62-47646号公報, 同62-3 6674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報。同60-93445号公報。同60 -94462号公報, 同60-174749号公報, 同 60-175052号公報などに記載のもの) などを挙

> 【0044】これらの化合物は正孔伝達化合物として使 用することができるが、次に示すポルフィリン化合物 (特開昭63-295695号公報などに記載のもの) 及び芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合 物 (米国特許第4.127.412号明細書, 特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54 -149634号公報,同54-64299号公報,同 55-79450号公報, 同55-144250号公 報。同56-119132号公報。同61-29555 8号公報,同61-98353号公報,同63-295 695号公報などに記載のもの)、特に該芳香族第三級 アミン化合物を正孔伝達化合物に用いることが好まし

[0045] 該ポルフィリン化合物の代表例としては、 ポルフィリン:5,10,15,20-テトラフェニル -21H、23H-ポルフィリン銅(II):5、10、 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフ イリン亜鉛 (II) : 5, 10, 15, 20-テトラキス (ペンタフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフ 報,同46-3712号公報,同47-25336号公 50 ィリン;シリコンフタロシアニンオキシド;アルミニウ

ムフタロシアニンクロリド: フタロシアニン (無金 展) ; ジリチウムフタロシアニン ; 網テトラメチルフタ ロシアニン: 銅フタロシアニン: クロムフタロシアニ ン: 亜鉛フタロシアニン: 鉛フタロシアニン: チタニウ ムフタロシアニンオキシド:マグネシウムフタロシアニ ン;網オクタメチルフタロシアニンなどが挙げられる。 また該芳香族第三級化合物及びスチリルアミン化合物の 代表例としては、N, N, N', N'-テトラフェニル - (1, 1'-ピフェニル) -4, 4'-ジアミン: N, N'-ピス (3-メチルフェニル)-N, N'-ジ フェニルー (1, 1'ーピフェニル) ー4, 4'ージア ミン; 2, 2-ピス (4-ジ-p-トリルアミノフェニ ル) プロパン: 1、1 ーピス (4 ージー p ートリルアミ ノフェニル) シクロヘキサン; N, N, N', N'-テ トラーロートリルー (1、1'ーピフェニル)-4、 4'-ジアミン; 1, 1-ビス (4-ジ-p-トリルア ミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキサン: ピス (4-ジメチルアミノー2-メチルフェニル) フェニル メタン;ピス (4ージーpートリルアミノフェニル) フ ェニルメタン: N. N' -ジフェニル-N. N' -ジ (4-メトキシフェニル) - (1, 1'-ピフェニル) -4, 4' -ジアミン: N, N, N', N' -テトラフ*

[0048] などのニトロ関換フルオレノン誘導体、 [0049]

(4:24)

(k2 51

【0050】などのチオピランジオキシド誘導体、 【0051】

【0052】などのジフェニルキノン誘導体(「ポリマー・ブレブリント(Polymer Preprints),ジャパン」第37巻,第3号,第681ページ(1988年)などに配載のもの)、あるいは

[0053]

【化26】

* \mathbf{x} \mathbf{n} $\mathbf{n$

26

【0046】上店有機足1、果子における該正孔主人給送 局は、これらの正孔氏透化合物一種又は二種以上からな る一部で構成されてもよいし、あるいは、前配配とは別 顔のた合物からなる正孔注入輸送局を収配したものであ ってもよい。一方、前記(3)の構成の日、素子によけ る電子注入層(電子往入輸送局)は、電子伝達化合物か らなるものであった、接帳より注入された電子を発光局 物について物に網膜はなく、従来公知の化合物の中から 任意館でも数では、近米公式の化合物の中から 任意のものを選択して用いることができる。就電子伝達 化合物の好ましい例としては、

20 [0,047]

【0054】などの化合物 【「ジャーナル・オブ・アブ
の ライド・フィジックス (1. Apply, Phys.) 」第278、
第269頁(1988年)などに記載のもの)や、アントラキノジメクン誘導体 (特別昭57-1149259号
公報、同58-55450号公報、同61-22515
日公報、同61-233750号公報、同63-10
4061号公報などに記載のもの)、フレオレニリデンメクが誘導体 (特別昭60-6957号公報、同61-143764号の日61-148159号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-2515151号公報、同61-233750号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-223750号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-238750号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-238750号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-238750号公報などに必要なもの)、アントロン誘導体 (特別昭61-238750号公報などに必要なもの)。また、次中では、公司とは、日本の人の人間に対していません。

30 記載のもの) また、久の一放丸 (A) 入は (I

··· (B)

(0056) (次中、Ar' ~ Ar' 及びAr' はそれ ぞれ旋江に関東江無関奏のアリール基を示す。)で表される は関東文は無関象のアリーレ基を示す。)で表される 電子伝達化合物が挙げられる。ここで、アリール基とし ではフェニル基。アンチリーストルス・アントラ ニル基、ペリレニル基、ピレエル基等が挙げられ、アリ ーレン基、アントラモニレン基、ペリレニル及、ピレッ エレン基、アントマニンと基、ペリレニル及、ピレッ

※ニレン基等が挙げられる。また、置換基としては炭素数 1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキン基 又はシアノ基等が挙げられる。この一般式(A)又は(B)で表される化合物は、蕁腹形成性のものが好まし い。一般式(A)又は(B)で表される化合物の具体例 としては、 [0057]

[4:28]

0 0 5 8 】 * * 【化2 9

$$(CH_3)^3C$$

[0059]

[0060] 等が挙げられる。

【0061】「Appl. Phys. Lett. 1第55巻、第148 9ページ (1989年) に開示されているオキサジアゾ 一ル誘導体などを挙げることができる。なお、正孔注入 輸送層及び電子注入層は電化の注入性、輸送性、障壁性 のいずれかを有する層であり、上記した有機材料の他に S1系、S1С系、CdS系などの結晶性ないし非結晶 性材料などの無機材料を用いることもできる。有機材料 を用いた正孔注入輸送層及び電子注入層は発光層と同様 にして形成することができ、無機材料を用いた正孔注入 10 輸送局及び電子注入層は直空蒸着法やスパッタリングな どにより形成できるが、有機及び無機のいずれの材料を 用いた場合でも発光層のときと同様の理由から真空蒸着 法により形成することが好ましい。

【0062】次に、本発明の有機EL素子を作製する好 適な方法の例を、各構成の素子それぞれについて説明す る。前記の脳板/発光層/陰極からなるEL素子の作製 **法について説明すると、まず適当な基板上に、所望の意** 極物質、例えば脳極用物質からなる薄膜を、1 um以 うに、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成さ せ、脳極を作製したのち、この上に発光材料である一般 式(1)で表される4官能スチリル化合物化合物の蓮葉 を形成させ、発光層を設ける。該発光材料の糠膜化の方 法としては、例えばスピンコート法、キャスト法、蒸着 法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホ ールが生成しにくいなどの点から、蒸着法が好ましい。 該発光材料の蒋睒化に、この蒸着法を採用する場合、そ の蒸着条件は、使用する発光層に用いる有機化合物の種 より異なるが、一般にポート加熱温度50~400℃。 真空度10-6~10-8Pa, 蒸着速度0,01~50nm /sec, 基板温度-50~+300℃, 膜厚5nmな いし5μmの範囲で適宜選ぶことが望ましい。次にこの 発光層の形成後、その上に跨極用物質からなる趣障を、 1 μm以下、好ましくは50~200nmの範囲の聴題 になるように、何えば蕪着やスパッタリングなどの方法 により形成させ、陰極を設けることにより、所望のEL 素子が得られる。なお、このEL素子の作製において は、作製順序を逆にして、陰極、発光層、陽極の順に作 40 【0066】 製することも可能である。

【0063】また、一対の電極間に正孔注入輸送材料。 発光材料、電子往入材料を混合させた形で電極間に挟持 させ発光層とした、陽極/発光層/陰極からなる素子の 場合の作製方法としては、例えば適当な基板の上に、陽 極用物質からなる薄膜を形成し、正孔注入輸送材料、発 光材料、電子注入材料、ポリビニルカルパゾール等の結 着剤等からなる溶液を整布するか、又はこの溶液から浸 漬除工法により薄膜を形成させ発光層とし、その上に陰 極用物質からなる薄膜を形成させるものがある。ここ で、作製した発光層上に、さらに発光層の材料となる素 子材料を真空蒸着し、その上に除極用物質からなる蒸蹲 を形成させてもよい。あるいは、正孔注入輸送材料、電 子注入材料および発光材料を同時蒸着させ発光層とし、 そのトに陰極用物質からなる薬職を形成させてもよい。

30

【0064】次に、陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰 極から成るEL素子の作製法について説明すると、ま ず、陽極を前紀のEL素子の場合と同様にして形成した のち、その上に、正孔伝達化合物から成る薄膜をスピン コート法などにより形成し、正孔注入輸送層を設ける。 この数の条件は、前記発光材料の薄膜形成の条件に準じ ればよい。次に、この正孔注入輸送層の上に、順次発光 層及び陰極を、前記EL素子の作製の場合と同様にして 思けることにより、所望のEI、妻子が得られる。なお、 このEL素子の作製においても、作製順序を逆にして、

下、好ましくは10~200nmの範囲の談厚になるよ 20 陰極、発光層、正孔注入輸送層、陽極の順に作製するこ とも可能である。さらに、陽極/正孔注入輸送層/発光 個/電子注入層/除極から成るEL素子の作製法につい て説明すると、まず、前紀のEI 泰子の作製の場合と同 様にして、陽極、正孔注入輸送層、発光層を順次設けた のち、この発光層の上に、電子伝達化合物から成る薄膜 をスピンコート法などにより形成して、電子往入層を設 け、次いでこの上に、陰極を前記EL妻子の作製の場合 と同様にして設けることにより、所望のEL素子が得ら れる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序 類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などに 30 を逆にして、陽極、電子注入層、発光層、正孔注入輸送 層、陽極の順に作製してもよい。

> 【0065】 このようにして得られた本発明の有機EL 秦子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+、除極 を一の極性として電圧1~30 V程度を印加すると、発 光が透明又は半透明の電板側より観測できる。また、逆 の極性で世圧を印加しても電流は流れず発光は全く生じ ない。さらに、交流電圧を印加する場合には、脳極が +, 陰極が-の状態になったときのみ発光する。なお、 印加する交流の波形は任意でよい。

【実施例】次に本発明を、合成実施例及び素子作成例に よりさらに詳しく説明する。

合成実施例1

[0067]

[化31]

【0068】化合物A1.0g(0.0012モル),カリ ウムー t - プトキシドO. 2 2 g (O. 0 0 2 モル) をジメ チルスルホキシド (DMSO) 30ミリリットルに懸潤 させ、室温 (20~25℃) で20時間反応させた。得 られた反応物を一晩放價後、メタノール50ミリリット ルを添加し、析出した白色粉末を濾過して得られた破塊 をシリカゲルカラム (展開溶媒: 塩化メチレン) にて精 製した。その結果得られた白色粉末を塩化メチレンーメ タノールにて再沈させ、白色結晶を0.4g (収率23.8 %) 得た。この結晶の融点は170~170.5℃であっ た。質量分析 (FD-MS) の結果、M* (m/Z=1 400)、M2* (m/Z=700) であった。さらに元 素分析の結果 (() は計算値)、C110 Haoとして

C: 94.28% (94.25%)

H: 5.72% (5.75%)

であった。以上から、目的の化合物(13)が合成され ていることが確認された。

[0069] 秦子作成例1

2 5 mm×7 5 mm×1, 1 mmのガラス基板上に蒸着法により 厚さ100nmの1TO膜(陽極に相当)を設けたもの を透明支持基板とした。この透明支持基板をイソプロピ ルアルコールで5分間超音波洗浄し、さらに純水中で5 分間超音波洗浄した後、UVイオン洗浄器(サムコイン ターナショナル社製) にて基板温度150℃で20分間 洗浄した。この透明支持基板を乾燥窒素ガスで乾燥して 市販の蒸着装置 (日本真空技術 (株) 製) の基板ホルダ ーに固定し、モリプテン製の抵抗加熱ポートにCu配位

mg入れ、また別のモリプテン製ポートの抵抗加熱に N, N'-ビス (3-メチルフェニル)-N, N'-ジ フェニルー (1、1'-ピフェニル)-4、4'-ジア ミン (以下、TPDと略す。) を200mg入れ、さら に別のモリプテン製の抵抗加熱ポートに合成実施例1で 得られた化合物 (13) で表される (DPV) 6 BiV を200mg入れた。次いで、真空圏を4×10~Pa まで減圧した後、CuPcの入った前配加熱ポートに満 電して350℃まで加熱し、蒸着速度0.1~0.3nm/ 砂で透明支持基板上に蒸着して膜厚20mmのCuPc 層を設けた。このときの基板温度は室温であった。そし て、TPDの入った前記加熱ポートに通常して215℃ まで加熱し、蒸着速度0.1~0.3 nm/秒で上記CuP c 層の上にTPDを蒸着して膜厚40nmのTPD層を 設けた。このときの基板温度も室温であった。このよう にして設けたCuPc層とTPD層の2層が、正孔往入 輸送層に該当する。次いで、(DPV)。BiVの入っ 40 た前記加熱ポートに通電して300℃まで加熱し、蒸着 速度0.1~0.3 nm/砂で上配TPD層の上に蒸着して 膜厚40 nmの発光層を設けた。次に、これ3層の有機 **物層を箱層した透明支持基板を真空標から取り出し、発** 光槽の上にステンレススチール製のマスクを配置して再 び基板ホルダーに固定した。次いで、モリブデン製の抵 抗加熱ポートにトリス (8-キノリノール) アルミニウ ム (以下、Ala, と略す。) を200mgを入れて真 空槽に蒸着した。さらに、マグネシウムリボン1gを入 れたモリプデン製の抵抗加熱ポートと銀ワイヤー500 のフタロシアニン(以下、CuPcと略す。)を200 50 mgを入れたタングステン製パスケットとを真空槽に装

22

着した。その後、真空槽を1×10 - 1 Paまで減圧し た。減圧後、Ala。を入れたポートを270℃まで加 終し、蒸着速度0.1~0.3 nm/秒で発光層上にAlq , を蒸着して隙厚40nmのAlg, 層(低子注入層に 相当)を設けた。続けて、銀ワイヤー入りのパスケット に通電して蒸着速度0.1nm/秒で銀を蒸着させると同 時にマグネシウムリポン入りのポートに通電して蒸着速 度1.4~2.0 nm/秒でマグネシウムを蒸着した。この 二元同時蒸発により、Alax 層上に聴厚20nmのマ グネシウム-銀層(陰極に相当)が形成された。この素 10 形成されるのである。 子のITO電極を脳極とし、マグネシウムー銀層を陰極 として、直流10Vを印加したところ、電流密度が14 ミリアンペア/cm2 の電流が流れ、ピーク波長470 nmのB!ueの発光を得た。このときの輝度は180 c d/m2 であり、発光効率は0.41ルーメン/Wであ った。得られた発光は、 (DPV) 。 BiVの固体蛍光 とほぼ一致することから (DPV) 。 BiVからの発光

と確認された。得られた素子には、均一な蒋晓が形成さ れ1カ月以上も結晶化することはなかった。これは、発 光材料として用いた (DPV) BiVが1分子中に7 箇所のオレフィン部位を有しており、多種名様のコンフ オメーションをとりえることに由る。よって、発光材料 に用いた (DPV) 。 BiVは、分子の再配列を防ぐこ とになり、容易にアモルファス状態になることができ る。さらにこのアモルファス状態が均一なため、結晶化 されることがなくなるため妻子全体として安定な遊聴が

[0070]

【発明の効果】以上の如く、本発明の新規スチリル化合 物を用いたEL素子は発光効率に優れ、かつ高輝度発光 を可能とした。従って、本発明の新規スチリル化合物 は、催光増白染料、電子写真感光体などに有効に利用す ることができ、さらに、本発明の有機EL素子は各種発 光材料などに有効に利用することができる。

フロントページの統き

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 7 C 25/24		9280-4H		
41/30				
43/166		7419-4H		
209/68				
211/44		9280-4H		
211/54		9280-4H		
253/30				
255/32		9357-4H		
C 0 7 D 521/00				
C 0 9 K 11/06	2	9159-4H		
H 0 5 B 33/14				